

PR1 2000A1光刻胶 光刻胶 赛米莱德

产品名称	PR1 2000A1光刻胶 光刻胶 赛米莱德
公司名称	北京赛米莱德贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区博兴九路2号院5号楼2层208
联系电话	15201255285 15201255285

产品详情

NR9-3000PY光刻胶

二、预烘和底胶涂覆 (Pre-bake and Primer Vapor)

由于光刻胶中含有溶剂，所以对于涂好光刻胶的硅片需要在80度左右的。硅片脱水烘焙能去除圆片表面的潮气、增强光刻胶与表面的黏附性、通常大约100 °C。这是与底胶涂覆合并进行的。

底胶涂覆增强光刻胶(PR)和圆片表面的黏附性。广泛使用:
(HMDS)、在PR旋转涂覆前HMDS蒸气涂覆、PR涂覆前用冷却板冷却圆片。

政策扶持

为促进我国光刻胶产业的发展，RR41光刻胶，国家02重大专项给予了大力支持。今年5月，NR94 8000PY光刻胶，02重大专项实施管理办公室组织任务验收专家组、财务验收专家组通过了“极紫外光刻胶材料与实验室检测技术研究”项目的任务验收和财务验收。

据悉，经过项目组全体成员的努力攻关，PR1 2000A1光刻胶，完成了EUV光刻胶关键材料的设计、制备和合成工艺研究、配方组成和光刻胶制备、实验室光刻胶性能的初步评价装备的研发，光刻胶，达到了任务书中规定的材料和装备的考核指标。项目共申请发明专利15项（包括国际专利5项），截止到目前，共获得授权专利10项（包括国际专利授权3项）。

正性光刻胶的金属剥离技术

正性胶的金属剥离工艺对于获得难腐蚀金属的细微光刻图形比常规的光刻胶掩蔽腐蚀法显示了优越性。本文首先对金属剥离工艺中的正、负光刻胶的性能作了对比分析。认为正性光刻胶除图形分辨率高而适

应于微细图形的掩膜外，它还具有图形边缘陡直，去胶容易等独特性能，比负性光刻胶更有利于金属剥离工艺。然后给出了具体的工艺条件，并根据正性光刻胶的使用特点指出了工艺中的关键点及容易出现的问题。如正性光刻胶同GaAs表面的粘附性较差，这就要求对片子表面的清洁处理更为严格。为了高止光刻图形的漂移控制光刻图形的尺寸，对曝光时间特别是显影液温度提出了严格的要求。由于工艺中基本上不经过腐蚀过程，胶膜的耐腐蚀性降到了次要地位。

PR1 2000A1光刻胶-光刻胶-赛米莱德由北京赛米莱德贸易有限公司提供。“光刻胶”就选北京赛米莱德贸易有限公司（www.semild.com），公司位于：北京市北京经济技术开发区博兴九路2号院5号楼2层208，多年来，赛米莱德坚持为客户提供好的服务，联系人：况经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。赛米莱德期待成为您的长期合作伙伴！